
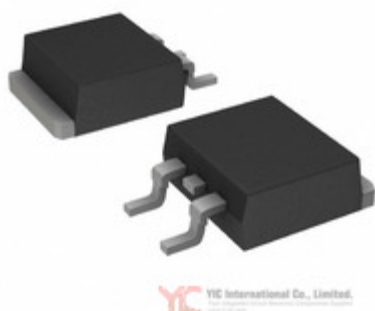
	<h2 style="color: red;">FQB7N10LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB7N10LTM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB7N10LTM.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB7N10LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 3.65A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7.3A (Tc) 3.75W (Ta), 40W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

FQB7N10LTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB7N10LTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB7N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB7N10LTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB7N10LTM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>	 <p>FQB7N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p>	 <p>FQB7N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p>	 <p>FQB7N10TM FSC FQB7N10TM FSC</p>
 <p>FQB7N10 FAIRCHILD FQB7N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB7N10L VB FQB7N10L VB</p>	 <p>FQB7N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p>	 <p>FQB7N20 FAIRC FQB7N20 FAIRC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB7N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB7N10LTM Datenblatt	FQB7N10LTM-Datenblätter	FQB7N10LTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB7N10LTM
FQB7N10LTM Electronic	FQB7N10LTM-Komponenten	FQB7N10LTM-Verteiler	FQB7N10LTM-Bild	FQB7N10LTM-Teil
FQB7N10LTM Preis	FQB7N10LTM Hersteller	FQB7N10LTM Bild	FQB7N10LTM Aktie	FQB7N10LTM Inventar
FQB7N10LTM Neu	FQB7N10LTM Original	FQB7N10LTM garantiert	FQB7N10LTM RFQ	FQB7N10LTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited